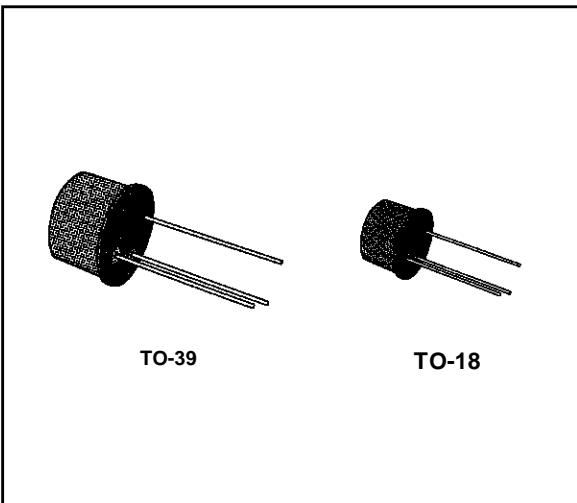


## HIGH-SPEED SWITCHES

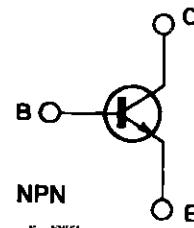
### DESCRIPTION

The 2N2218, 2N2219, 2N2221 and 2N2222 are silicon planar epitaxial NPN transistors in Jedec TO-39 (for 2N2218 and 2N2219) and in Jedec TO-18 (for 2N2221 and 2N2222) metal cases. They are designed for high-speed switching applications at collector currents up to 500 mA, and feature useful current gain over a wide range of collector current, low leakage currents and low saturation voltages.

2N2218/2N2219 approved to CECC 50002-100, 2N2221/2N2222 approved to CECC 50002-101 available on request.



### INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

| Symbol    | Parameter   | Value                  | Unit             |
|-----------|---|------------------------|------------------|
| $V_{CBO}$ | Collector-base Voltage ( $I_E = 0$ )  | 60                     | V                |
| $V_{CEO}$ | Collector-emitter Voltage ( $I_B = 0$ )   | 30                     | V                |
| $V_{EBO}$ | Emitter-base Voltage ( $I_C = 0$ )  | 5                      | V                |
| $I_C$     | Collector Current   | 0.8                    | A                |
| $P_{tot}$ | Total Power Dissipation at $T_{amb} \leq 25^\circ C$<br>for 2N2218 and 2N2219<br>for 2N2221 and 2N2222<br>at $T_{case} \leq 25^\circ C$<br>for 2N2218 and 2N2219<br>for 2N2221 and 2N2222 | 0.8<br>0.5<br>3<br>1.8 | W<br>W<br>W<br>W |
| $T_{stg}$ | Storage Temperature   | - 65 to 200            | °C               |
| $T_j$     | Junction Temperature  | 175                    | °C               |

## 2N2218-2N2219-2N2221-2N2222

---

### THERMAL DATA

|                         |                                     | <b>2N2218<br/>2N2219</b> | <b>2N2221<br/>2N2222</b> |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $R_{th\ j\text{-}case}$ | Thermal Resistance Junction-case    | Max                      | 50 °C/W                  |
| $R_{th\ j\text{-}amb}$  | Thermal Resistance Junction-ambient | Max                      | 187.5 °C/W<br>300 °C/W   |

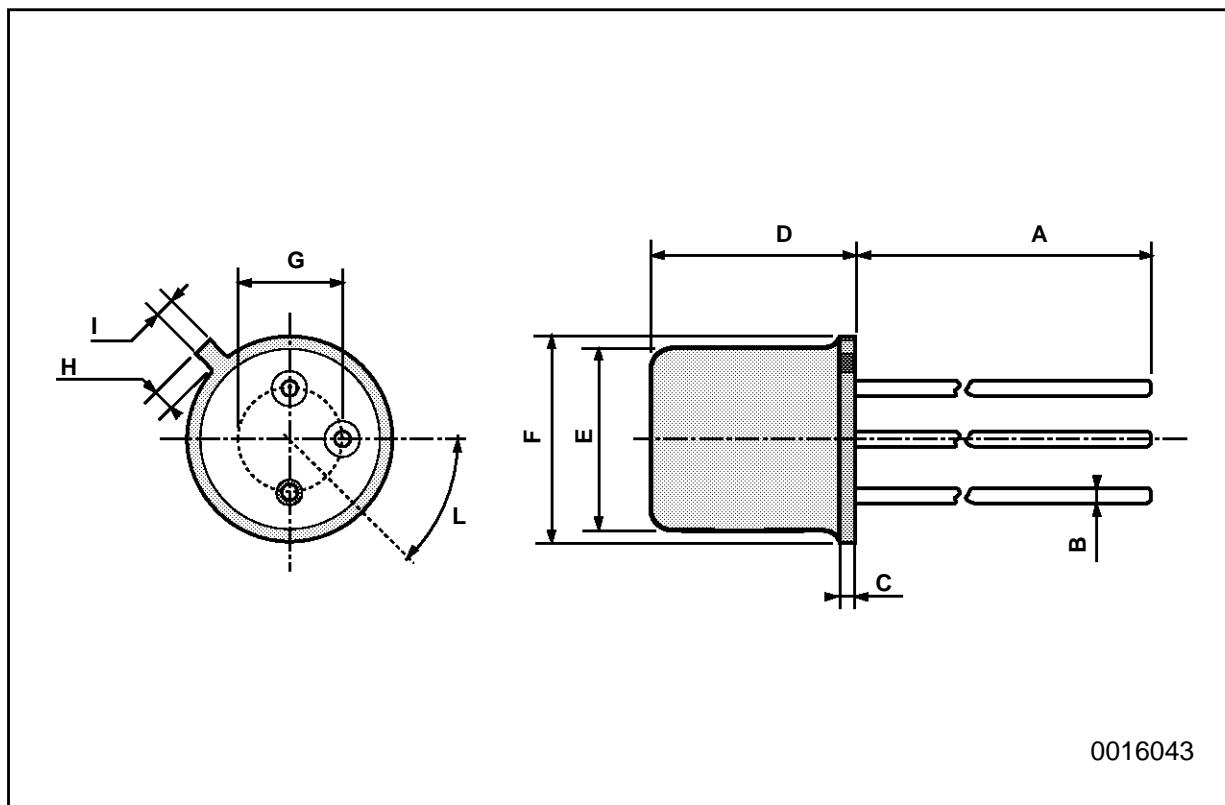
### ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)

| Symbol                   | Parameter   | Test Conditions  | Min.  | Typ. | Max.       | Unit     |
|--------------------------|---|--|---|------|------------|----------|
| $I_{CBO}$                | Collector Cutoff Current ( $I_E = 0$ )            | $V_{CB} = 50\text{ V}$<br>$V_{CB} = 50\text{ V}$ $T_{amb} = 150^\circ\text{C}$   |   |      | 10<br>10   | nA<br>μA |
| $I_{EBO}$                | Emitter Cutoff Current ( $I_C = 0$ )              | $V_{EB} = 3\text{ V}$  |   |      | 10         | nA       |
| $V_{(BR)\text{CBO}}$     | Collector-base Breakdown Voltage ( $I_E = 0$ )    | $I_C = 10\text{ μA}$   | 60  |      |            | V        |
| $V_{(BR)\text{CEO}}^*$   | Collector-emitter Breakdown Voltage ( $I_B = 0$ ) | $I_C = 10\text{ mA}$   | 30  |      |            | V        |
| $V_{(BR)\text{EBO}}$     | Emittter-base Breakdown Voltage ( $I_C = 0$ )     | $I_E = 10\text{ μA}$   | 5   |      |            | V        |
| $V_{CE\ (\text{sat})}^*$ | Collector-emitter Saturation Voltage              | $I_C = 150\text{ mA}$ $I_B = 15\text{ mA}$<br>$I_C = 500\text{ mA}$ $I_B = 50\text{ mA}$   |   |      | 0.4<br>1.6 | V<br>V   |
| $V_{BE\ (\text{sat})}^*$ | Base-emitter Saturation Voltage                   | $I_C = 150\text{ mA}$ $I_B = 15\text{ mA}$<br>$I_C = 500\text{ mA}$ $I_B = 50\text{ mA}$   |   |      | 1.3<br>2.6 | V<br>V   |
| $h_{FE}^*$               | DC Current Gain                                   | for <b>2N2218</b> and <b>2N2221</b><br>$I_C = 0.1\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$<br>$I_C = 1\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$<br>$I_C = 10\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$<br>$I_C = 150\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$<br>$I_C = 500\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$<br>$I_C = 150\text{ mA}$ $V_{CE} = 1\text{ V}$<br>for <b>2N2219</b> and <b>2N2222</b><br>$I_C = 0.1\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$<br>$I_C = 1\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$<br>$I_C = 10\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$<br>$I_C = 150\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$<br>$I_C = 500\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$<br>$I_C = 150\text{ mA}$ $V_{CE} = 1\text{ V}$ | 20<br>25<br>35<br>40<br>20<br>20<br>35<br>50<br>75<br>100<br>30<br>50 |      | 120<br>300 |          |
| $f_T$                    | Transition Frequency                              | $I_C = 20\text{ mA}$ $V_{CE} = 20\text{ V}$<br>$f = 100\text{ MHz}$  | 250   |      |            | MHz      |
| $C_{CBO}$                | Collector-base Capacitance                        | $I_E = 0$ $V_{CB} = 10\text{ V}$<br>$f = 100\text{ kHz}$   |   |      | 8          | pF       |
| $R_{e(hie)}$             | Real Part of Input Impedance                      | $I_C = 20\text{ mA}$ $V_{CE} = 20\text{ V}$<br>$f = 300\text{ MHz}$  |   |      | 60         | Ω        |

\* Pulsed : pulse duration = 300 μs, duty cyde = 1 %.

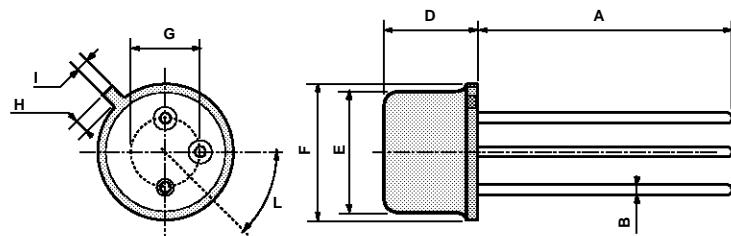
## TO-18 MECHANICAL DATA

| DIM. | mm   |      |      | inch  |       |       |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|
|      | MIN. | TYP. | MAX. | MIN.  | TYP.  | MAX.  |
| A    |      | 12.7 |      |       | 0.500 |       |
| B    |      |      | 0.49 |       |       | 0.019 |
| D    |      |      | 5.3  |       |       | 0.208 |
| E    |      |      | 4.9  |       |       | 0.193 |
| F    |      |      | 5.8  |       |       | 0.228 |
| G    | 2.54 |      |      | 0.100 |       |       |
| H    |      |      | 1.2  |       |       | 0.047 |
| I    |      |      | 1.16 |       |       | 0.045 |
| L    | 45°  |      |      | 45°   |       |       |



## TO39 MECHANICAL DATA

| DIM. | mm         |      |      | inch  |      |       |
|------|------------|------|------|-------|------|-------|
|      | MIN.       | TYP. | MAX. | MIN.  | TYP. | MAX.  |
| A    | 12.7       |      |      | 0.500 |      |       |
| B    |            |      | 0.49 |       |      | 0.019 |
| D    |            |      | 6.6  |       |      | 0.260 |
| E    |            |      | 8.5  |       |      | 0.334 |
| F    |            |      | 9.4  |       |      | 0.370 |
| G    | 5.08       |      |      | 0.200 |      |       |
| H    |            |      | 1.2  |       |      | 0.047 |
| I    |            |      | 0.9  |       |      | 0.035 |
| L    | 45° (typ.) |      |      |       |      |       |



P008B

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, SGS-THOMSON Microelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SGS-THOMSON Microelectronics. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. SGS-THOMSON Microelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of SGS-THOMSON Microelectronics.

© 1994 SGS-THOMSON Microelectronics - All Rights Reserved

SGS-THOMSON Microelectronics GROUP OF COMPANIES  
Australia - Brazil - France - Germany - Hong Kong - Italy - Japan - Korea - Malaysia - Malta - Morocco - The Netherlands -  
Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - Taiwan - Thailand - United Kingdom - U.S.A



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А